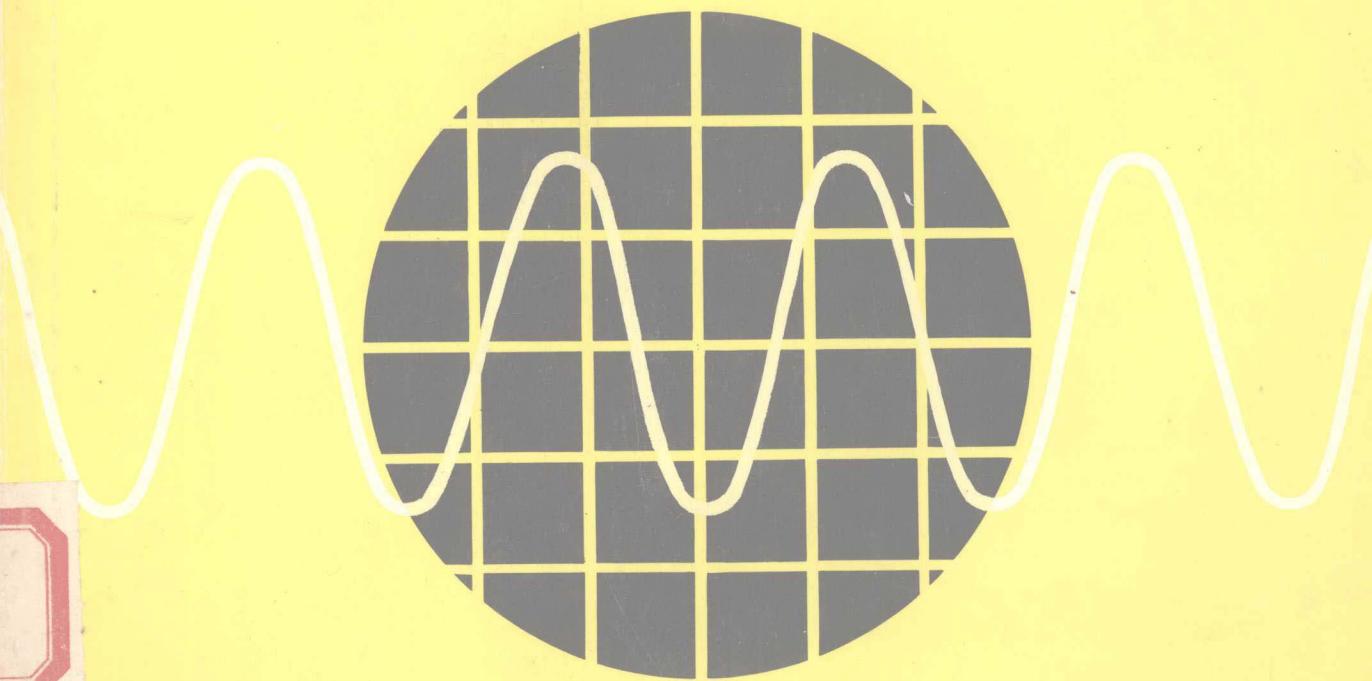


實用電子學(二)

(下冊)

魯 鐵 編 譯



知識叢書出版社

實用電子學(二)

魯 鐵 編 譯

(下冊)

知識叢書出版社

版權所有
翻印必究

實用電子學（二）

（下冊）

編 者：魯 鐵

出版者：知識叢書出版社
香港九龍彌敦道14號18

承印商：通文印刷公司
香港九龍斧山道12A

17°

符號表

二極體的特性和章六十

電流

I_E 射極電流 (DC)

I_e 射極電流 (均方根值)

i_e 射極電流 (瞬時值)

I_c 集極電流 (直流)

I_e 集極電流 (均方根值)

i_e 集極電流 (瞬時值)

I_B 基極電流 (直流)

I_b 基極電流 (均方根值)

i_b 基極電流 (瞬時值)

I_p 電洞流

I_n 電子流

I_D 二極體電流

I_s 飽和電流

I_{CBO} 在 $I_E = 0$ 時的集極電流

I_{CEO} 在 $I_B = 0$ 時的集極電流

電壓

V_{EB} 射極-基極電壓 (直流)

$V_{e.b}$ 射極-基極電壓 (均方根值)

$V_{e.b}$	射極-基極電壓 (瞬時值)
$V_{o.B}$	集極-基極電壓 (直流)
$V_{e.b}$	集極-基極電壓 (均方根值)
$V_{e.b}$	集極-基極電壓 (瞬時值)
$V_{o.E}$	集極-射極電壓 (直流)
$V_{o..}$	集極-射極電壓 (均方根值)
$V_{o..}$	集極-射極電壓 (瞬時值)
$V_{B.E}$	基極-射極電壓 (直流)
$V_{b..}$	基極-射極電壓 (均方根值)
$V_{b..}$	基極-射極電壓 (瞬時值)
V_D	二極體電壓 (直流)
<hr/>	
增 益	
G_P	功率增益 (直流)
G_I	電流增益 (直流)
G_V	電壓增益 (直流)
G_r	功率增益 (交流)
G_o	電流增益 (交流)
G_v	電壓增益 (交流)
α	共基極的電流放大因數
$\beta = \alpha'$	二共射極電流放大因數
$\alpha'' =$	共集極電流放大因數

其 他

(直頻率) 電壓過基-過場	d_{av}
(直直) 電壓過基-過場	d_{av}
(斜恩衣因) 電壓過基-過場	d_{av}
(斜直) 電壓過基-過場	d_{av}
(直直) 電壓過場-過場	d_{av}
(斜恩衣因) 電壓過場-過場	d_{av}
(直頻率) 電壓過場-過場	d_{av}
(壳直) 電壓過場-過場	μ
(斜恩衣因) 電壓過場-過場	μ_{p}
(斜直) 電壓過場-過場	μ_{p}
(斜頻率) 電壓過場-過場	μ_{n}
(直直) 電壓過場-過場	ν
(直直) 益銀率改	n
(直直) 益銀率原	p
(直直) 益銀率原	n_{i}
(直直) 益銀率原	p_{i}
(斜交) 益銀率改	D
(斜交) 益銀率原	D_{a}
(斜交) 益銀率原	D_{p}
導因大狀荷電過場共	q
導因大狀荷電過場共	k
導因大狀荷電過場共	波子曼常數

目 錄

18

上冊

第一章 二極體與電晶體的基本運用

- 組件及符號，二極體，電晶體。
- 串聯二極體的特性。
- 電晶體作電力控制元件。

19

第二章 固體的傳導

工 章五

22

- 原子結構，晶體結構，共價鍵，游離。
- 產生與復合，漂移，擴散。
- P- 及 N- 型半導體，雜質半導體。
- N- 型材料，P- 型材料。
- 多數及少數載子。

20

第三章 P-N 接面

51

- 在 P- 及 N- 型材料中多數及少數載子量，溫度的影響。
- P-N 接面，在 P-N 接面中的擴散。
- 空間電荷層或乏層，電位障。
- 有外施電壓接面情況，加上順向電壓以及順向電流之接面情況。
- 溫度的影響，順向電流情況。

21

一接面電容。
一半導體二極體。



第四章 晶體二極體的特性

82

- 一、二極體特性之量度。
- 二、二極體的反向破壞。
- 三、崩潰破壞。
- 四、曾納破壞。
- 五、熱破壞。

55

第五章 工 藝

導體與半導體

章二

121

- 一、基本材料（鋁與矽）。
- 二、區域精鍊，自由區域精鍊。
- 三、晶體。
- 四、合金法，擴散法，晶膜法。
- 五、一點觸二極體，金鍵二極體，實用二極體。
- 六、電阻器色碼，標準電阻範圍。

56

第六章 二極體應用(1)

138

- 一、用二極體作整流器。
- 二、半波整流。
- 三、全波整流。

前向後退過渡向風土喊，此前曲達舊路號找育一

第七章 二極體應用(2)

177

- 一、定位，動態電阻及電壓穩定。
- 二、跨於二極體兩端的電壓。

一動態電阻。
一電壓穩定。

第八章 二極體說明書

233

一設計問題，遞減。

。此圖入射與大於向又一

態時避素共 章二十葉

下冊

第九章 介紹電晶體共基極組態

一基極-射極二極體。

一集極-基極二極體的特性。

一等效電路。

一物理說明。

一三種組態，共基極，共射極，共集極。

一飽和與切止。

一用電晶體作放大器，增益。

達者設計小 章三十葉

第十章 共射極組態(直流情況)

73

直流條件

一射極-基極二極體。

一集極-基極二極體。

一大信號增益。

一共射極的切止。

一切止及 I_{CEO} 的理論說明。

用電晶體 章五十葉

第十一章 共射極組態 (交流情況)

117

交流條件

—共射極，交流負載的小信號增益。

—倒相，輸出失真。

—反向放大與輸入阻抗。

第十二章 共集極組態

153

—共集極組態的電壓，電流及功率增益，輸入以及輸出電阻。

—共集極組態的小信號特性。

—傳統電流。

第十三章 小信號參數

189

—共射極的 "h" 參數。

—設計問題。

第十四章 電晶體說明書

207

—AC125 電晶體資料表說明。

第十五章 電晶體的應用 I

231

—工作點的穩定與放大

—穩定工作點的設計程序。

—單級電晶體放大器，負載與直線性。

—設計問題。

抗流圈-電容器耦合，小頻帶放大器，正反饋與直
接耦合 (dc) 放大器。

一 實際應用。

第十七章 電晶體工藝

323

(一) 合金電晶體，功率電晶體。

一 合金擴散電晶體。

一 凸型電晶體。

一 晶膜電晶體。

(二) 晶膜平面電晶體。

(單面式) 濾波器基板

(雙面式) 濾波器基板

濾波器

電子管

高電壓整流器

高電壓管

高電壓整流器 $O = aI_{\text{正}} - \alpha a I_{\text{反}}$

高電壓整流器 $O = aI_{\text{正}} + \alpha a I_{\text{反}}$

(單面) 濾音器基板 $\pm 5V$

(雙面式) 濾音器基板 $\pm 5V$

本章由中華人民共和國科學技術部編寫，中國科學院物理研究所編輯

第九章 介紹電晶體共基極組態

在上一章中我們已經指出過電晶體的組態問題。在這一章中我們將要討論的是共基極組態。在共基極組態中，三極管的三個電極（基極、集電極和發射極）之間的關係是怎樣的呢？

在共基極組態中，三極管的三個電極之間的關係是怎樣的呢？在共基極組態中，三極管的三個電極之間的關係是怎樣的呢？在共基極組態中，三極管的三個電極之間的關係是怎樣的呢？

在共基極組態中，三極管的三個電極之間的關係是怎樣的呢？

集成電路中應用最廣的共基極組態

在集成電路中，應用最廣的共基極組態是怎樣的呢？在集成電路中，應用最廣的共基極組態是怎樣的呢？在集成電路中，應用最廣的共基極組態是怎樣的呢？

在集成電路中，應用最廣的共基極組態是怎樣的呢？

緒論

在本章中我們所要研討的，為電晶體的基本電學上與物理學方面的特性。

在第一章中我們已經看出電晶體是一種半導體元件，如圖 9.1 的圖解圖即表示其理想的結構。在此處由二個 P 區將 N 區夾在當中，這樣就形成 PNP 電晶體。三個電極分別為射極、基極，以及集極。

從圖 9.2 即可看出，三區實際就是以 N 區為共同所有的兩個二極體反向連接而成。由射極與基極所形成的二極體 1，稱為 e-b 二極體，由集極與基極所形成的二極體 2，稱為 e-b 二極體。

我們就利用這兩個二極體的概念，來引導出我們研討電晶體極重要的知識。

所備各個實驗都要全部展示二極體，如圖 9.2 所示連接時，各自在正常情況的順向以及反向特性，及其相互之間的作用。

這種相互之間的作用，就是電晶體放大性質的根源。

射極 (e)

集極 (c)



圖 9-1
NPN 晶體管之結構與其電路圖

此圖示出 NPN 晶體管之結構，由三層半導體材料所組成。最上層為 P 型，中間為 N 型，最下層為 P 型。此三層之間有兩種接觸點：基極 (b)、射極 (e) 及集極 (c)。基極接觸點位於最下層 P 型半導體之上；射極接觸點位於最上層 P 型半導體之上；集極接觸點則位於中間 N 型半導體之上。

半導體管是由 P 型半導體及 N 型半導體所組成。

半導體管是由 P 型半導體及 N 型半導體所組成。

半導體管是由 P 型半導體及 N 型半導體所組成。



圖 9-2
半導體二極管之結構與其電路圖

此圖示出半導體二極管之結構，由兩層半導體材料所組成。最上層為 N 型，最下層為 P 型。此兩層之間有一個接觸點，稱為正極 (a)，另一個接觸點稱為負極 (b)。當正極接觸點加上正向電壓時，電子將由 N 型半導體流向 P 型半導體，此時二極管導通；當負極接觸點加上正向電壓時，空穴將由 P 型半導體流向 N 型半導體，此時二極管導通。

圖 9-2

在我們着手由實驗探討其性質之前，先來察看典型的PNP電晶體的機械特徵。

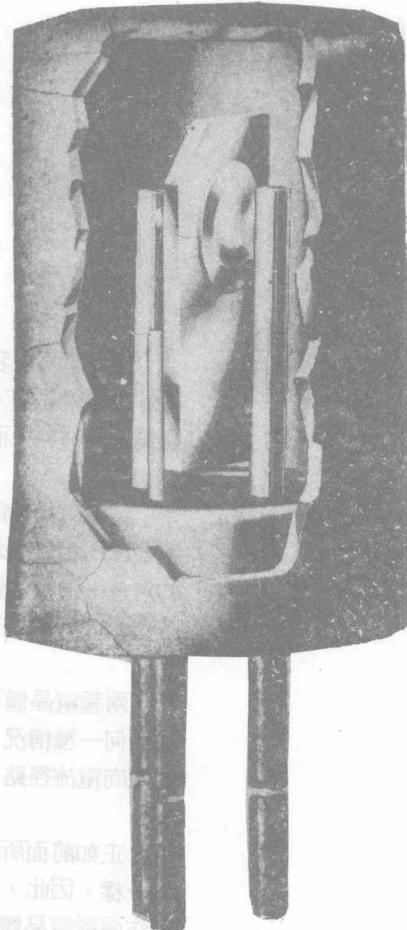
圖9.3所示的電晶體就是在第一章實驗中所使用的相類似的電晶體。為了便於讓我們對其結構看得更清楚起見，所示圖形已將該元件放大，並且剖開。

其中央，或基極引線，接於對摻雜的N型材料盤為低電阻率材料的晶片上，這就是基極。集極與射極則用銻材料球，以合金的方式在基極的兩邊形成。裝妥之後整件密封在玻璃或是金屬壳中，以避免受潮。

基極區控制電晶體絕大部份的特性，通常其寬度都要作得很窄。

由三個電極所接出的引線，一般都由鍍金或是鍍錫銅線作成，而由壳的底部從玻璃密封口穿出來。

其中集極引線，都在緊靠外殼利用一點來識別。



■ 9-3

圖說二 d-e 氣泡標示器門牌。中標實面二面不平
一對齊向風吹標說二 d - e 氣孔，並對齊向頭吹

到目前為止我們都只提及 PNP 電晶體。其實際 NPN 另外這種電晶體，其用途也是一樣。如圖 9.4 所示，則以 P- 型為基極材料，而以 N- 型材料作為射極與集極。

這類電晶體的工作原理，除了全部電流以及電位的符號與 PNP 相反而外，其他完全一樣。兩種電晶體扮演着互補的角色，這種性質能使設計者獲得許多極為有用的電路組態，稍後即將講述。

兩種電晶體可以由圖 9-5 所示其電的符號予以辨認。在任何一種情況，其中射極箭頭的方向都表示 e-b 二極體的順向電流徑路。

正如前面所述，PNP 電晶體的工作方式與 NPN 電晶體一樣，因此，在本課程中為了方便計只講 PNP 電晶體以及作兩種電晶體簡單的比較。

在下面的二個實驗中，我們所要研討的為 e-b 二極體的順向特性性能，以及 c - b 二極體的反向特性。